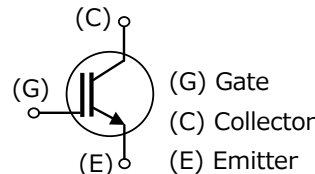




パワー半導体 IGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ) MR-Series 650V/200A LowVCEsat

# MMJ65B0A02\*\*



## 概要

当社のIGBT（ヘアチップ）は、アナログ半導体デバイス製造で培った様々な技術を活用し、高効率化と省エネルギー化に貢献できる幅広い高電圧・大電流対応の製品を揃えています。

## 用途

- ・産業機器
- ・汎用インバータ
- ・溶接機
- ・無停電電源装置（UPS）

## 特長

- ① フィールドストップトレンチゲートIGBT
- ② 低コレクタ飽和電圧
- ③ 高短絡耐量
- ④ 低スイッチング損失

## 最大定格

特記なき場合 Tj=25deg.

項目	記号	製品規格	単位
コレクタ・エミッタ耐圧	VCES	650	V
ゲート耐圧	VGES	±30	V
コレクタ電流 *1)	IC	200	A
接合温度	Tj	-40~+175	℃

\*1)コレクタ電流は、Tj (max) 、および組立後の熱特性によって制限されます。

## チップ仕様

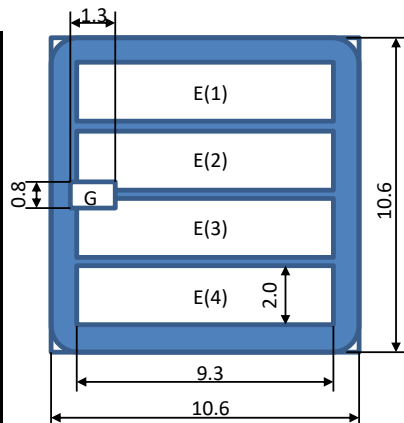
項目	値	単位
チップ厚	90	μm
チップサイズ	10.6x10.6(112.4)	mm
表面電極	6.5	μm
裏面電極	1.25	μm

## 電気的特性

特記なき場合 Tj=25deg.

項目	記号	製品規格			単位	条件	
		Min	Typ	Max			
コレクタリーク電流	ICES	-	-	1	μA	Vce=650V, Vge=0V	
ゲートリーク電流	IGES	-	-	±500	nA	Vge=±30V, Vce=0V	
閾値電圧	VGE(th)	5.00	-	6.80	V	Vce=10V, Ic=4.0mA	
飽和電圧	VCE (sat)	Tj=25℃	-	1.3	1.6	V	Ic=200A, Vge=15V
		Tj=175℃	-	1.5	-		
入力容量	Cies	-	16000	-	pF	VCE=25V, VGE=0V, f=1MHz	
帰還容量	Cres	-	600	-	pF		
スイッチング時間 ※参考特性	td(on)	-	100	-	ns	Vcc=300V, Ic=200A	
	tr	-	100	-	ns	VGE=-15/+15V, Rg=10.0Ω, Inductive load, Ls≒100nH	
	td(off)	-	500	-	ns		
	tf	-	250	-	ns		
短絡耐量	Tsc	10	-	-	μs	Vcc=360V, Vge=15V, Tj=150℃	

## チップ外形図



この特性はモールドパッケージまたは評価基板に組み込んだ場合の特性です。組立条件等によっては満足できない場合があります。保証値ではありませんのでご了承ください。

